Date d'édition : 29.11.2026

Ref : 559921

Détecteur semiconducteurs



Pour la mise en évidence de rayonnements a et ß (mesure de l'intensité) ainsi que pour l'enregistrement de spectres d'énergie a. Photodiode au silicium « rapide » et de grande surface dont la couche diélectrique absorbe complètement les particules a et partiellement les particules ß. L'amplitude des impulsions de sortie est proportionnelle à l'énergie des particules a. Photodiode incorporée dans la prise BNC et protégée par un manchon métallique contre une incidence perturbatrice de la lumière. Avec diaphragme à fente pour une utilisation dans la chambre à diffusion de Rutherford.

Caractéristiques techniques :

Surface active : 3,8 mm x 3,8 mm
Fréquence limite : 1 MHz
Tension initiale nécessaire : 8 V- ... 60 V-
Dimensions : 4 cm x 1,2 cm Ø

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Physique atomique et nucléaire > Analyse de l?énergie > Spectroscopie α et β